



南开大学

电磁学 (Electromagnetism)

2017/4/11

1



本章目录 (15-18)

- △ 8.15 导体的静电平衡条件
- 8.16 静电平衡时导体上的电荷分布规律
- △ 8.17 有导体时静电场的分析与计算
- 8.18 静电屏蔽

2017/4/11

2



导体 绝缘体

1. 导体 存在大量的可自由移动的电荷
conductor (电子数密度很大, 约为 10^{22} 个/ cm^3)
2. 绝缘体 理论上认为一个自由移动的电荷也没有。也称 电介质 dielectric
3. 半导体 介于上述两者之间 semiconductor
(电子数密度约为 $10^{12} \sim 10^{19}$ 个/ cm^3)

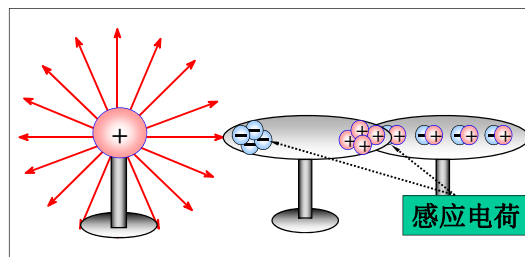
本部分讨论金属导体和电介质对场的影响

2017/4/11

3

△ 8.15 导体的静电平衡条件 (electrostatic equilibrium of conductor)

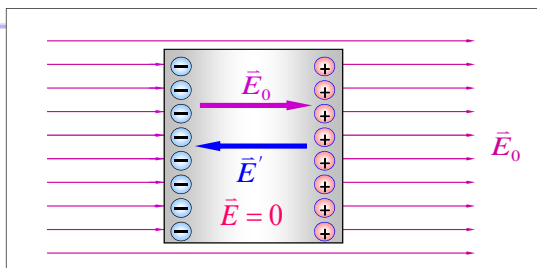
1 静电感应



2017/4/11

4

2 静电平衡



静电平衡 electrostatic equilibrium:
导体内部和表面无自由电荷的定向移动,
说导体处于**静电平衡状态**。

2017/4/11

5

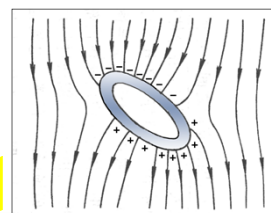


静电平衡条件:

- (1) 导体内部任何一点处的电场强度为零;
 $E_{\text{内}} = 0$
- (2) 导体表面处电场强度的方向, 都与导体表面垂直.



2017/4/11





3. 导体的电势

导体静电平衡时，导体各点电势相等，即导体是等势体，表面是等势面。

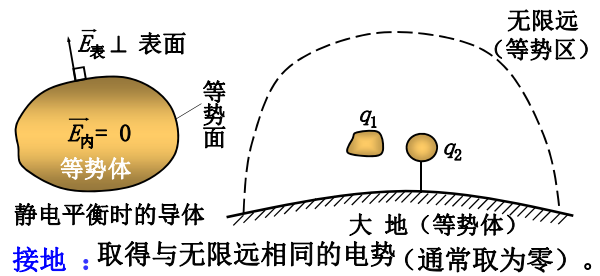
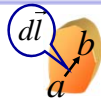
$$U = c$$

证：在导体上任取两点 a 和 b

$$U_a - U_b = \int_{(a)}^{(b)} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \quad U_a = U_b$$

导体等势是导体体内电场强度处处为零的必然结果

静电平衡条件的另一种表述



2017/4/11

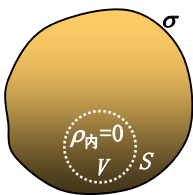
8



8.16 静电平衡时导体上电荷分布规律

一. 导体静电平衡时电荷分布在表面

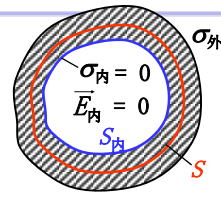
1. 实心导体： σ 可不为 0，但 $\rho_{内}$ 必为 0。



理由：
 $\therefore \vec{E}_{内} = 0$ ，
 $\therefore \oint_S \vec{E}_{内} \cdot d\vec{s} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho_{内} dV = 0$ ，
 S 是任意的。
 令 $S \rightarrow 0$ ，则必有 $\rho_{内} = 0$ 。

2017/4/11

2. 导体壳： $\sigma_{外}$ 可不为零，但 $\sigma_{内}$ 和 $E_{内}$ 必为零。



理由：
 在导体中包围空腔选取高斯面 S ，则：
 $\oint_S \vec{E}_{内} \cdot d\vec{s} = 0 \rightarrow$
 $\sigma_{内} = 0$ ，若 $\sigma_{内} \neq 0$ ，则 $\sigma_{内}$ 必有正负 \rightarrow

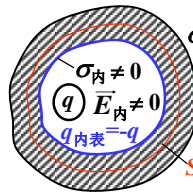
\vec{E} 线从正电荷到负电荷 \rightarrow 与导体静电平衡矛盾
 \rightarrow 只能 $\sigma_{内} = 0$ ，且腔内无 \vec{E} 线 \rightarrow 只能 $\vec{E}_{内} = 0$ 。

2017/4/11



3. 导体壳内有电荷：

$\sigma_{外}$ 可不为 0，但必有 $\sigma_{内} \neq 0$ ，
 且 $q_{内表} = -q$



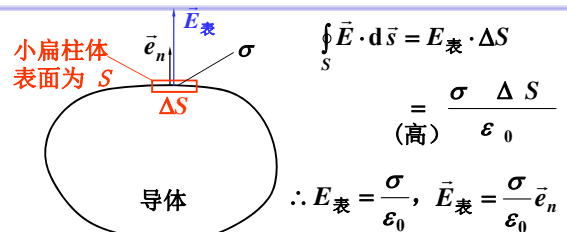
理由：
 在导体中包围空腔做高斯面 S ，则：
 $\oint_S \vec{E}_{内} \cdot d\vec{s} = \frac{1}{\epsilon_0} (q + q_{内表}) = 0$
 $\therefore q_{内表} = -q$

2017/4/11

11



二. 表面场强与面电荷密度的关系



思考 $\vec{E}_{表}$ 是小柱体内电荷的贡献还是导体表面全部电荷的贡献？从推导中的哪一步可看出？

2017/4/11

12



三. 孤立导体表面电荷分布的特点

孤立导体表面曲率大处面电荷密度也大，
但不存在单一函数关系。

面电荷密度与曲率半径的关系

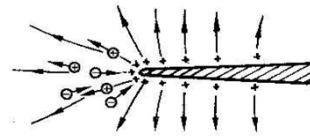
$$\sigma_e = \begin{cases} \text{表面凸出尖锐处 (曲率大)} \Rightarrow \text{大} \Rightarrow E \text{大} \\ \text{表面较平坦处 (曲率小)} \Rightarrow \text{小} \Rightarrow E \text{小} \\ \text{表面凹进去处 (曲率为负)} \Rightarrow \text{更小} \Rightarrow E \text{更小} \end{cases}$$

2017/4/11

13

尖端放电 (point discharge):

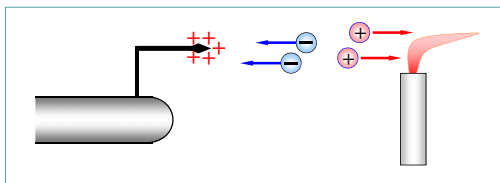
带电的尖端电场强，使附近的空气电离，
因而产生放电。



2017/4/11

14

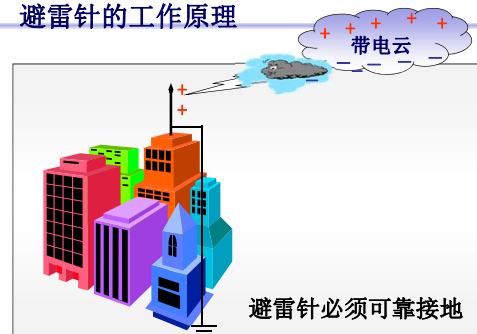
电风“吹”蜡烛 (KD011)



2017/4/11

15

避雷针的工作原理

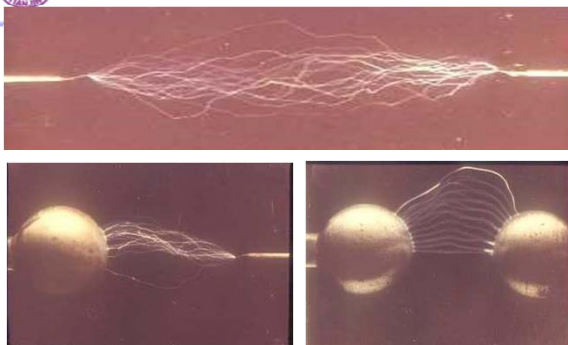


2017/4/11

16



空气中的直流高压放电图片:



2017/4/11

17



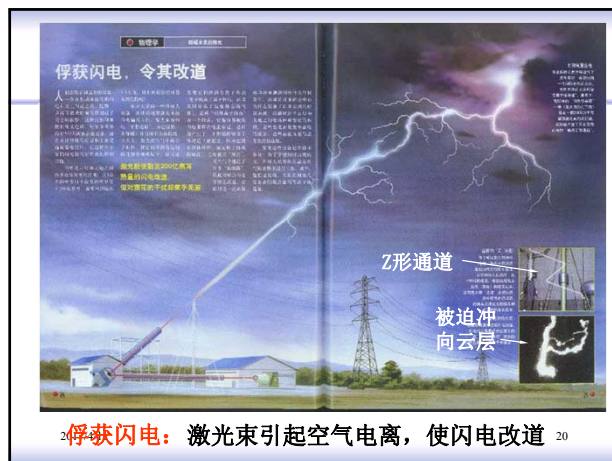
闪电的图片:



云层和大地间的闪电

2017/4/11

18



金属尖端的强电场的应用一例

场离子显微镜 (FIM)

原理:
样品制成针尖形状，
针尖与荧光膜之间加高压，
样品附近极强的电场使吸附在表面的 H_e 原子电离，氢离子沿电力线运动，
撞击荧光膜引起发光，
从而获得样品表面的图象。

接真空泵或充氮气设备

金属尖端

荧光质导电膜

接地

+ 高压

21

△ 8.17 有导体时静电场的分析与计算

原则:

1. 静电平衡的条件

$$E_{\text{内}} = 0 \quad \text{or } U = c$$
2. 基本性质方程

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0} \quad \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$
3. 电荷守恒定律

$$\sum_i Q_i = \text{const.}$$

22

依据: 静电平衡条件, 电荷守恒, 高斯定理。

[例1] 已知: 面电荷密度为 σ_0 的均匀带电大平板旁, 平行放置一大的不带电导体平板。

求: 导体板两表面的面电荷密度。

解: 设导体电荷密度为 σ_1 、 σ_2 ，

电荷守恒: $\sigma_1 + \sigma_2 = 0$ (1)

导体内场强为零: $E_0 + E_1 - E_2 = 0$

$\rightarrow \frac{\sigma_0}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} = 0 \rightarrow \sigma_0 = \sigma_2 - \sigma_1$ (2)

23

(1)、(2) 解得: $\sigma_1 = -\sigma_2 = -\frac{\sigma_0}{2}$

思考 若上例中导体板接地, 下面结果哪个正确?

(A) σ_0 $-\frac{\sigma_0}{2}$ 0

(B) σ_0 0 $\frac{\sigma_0}{2}$

(C) σ_0 $-\sigma_0$ 0

24



[例2] 金属球A与金属球壳B同心放置

已知：球A半径为 R_0 带电为 q

金属壳B内外半径分别为 R_1, R_2

带电为 Q

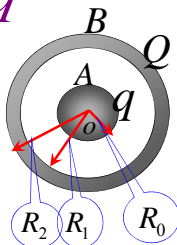
求：1) 电量分布

2) 球A和壳B的电

势 U_A, U_B

2017/4/11

25



解：

1) 导体带电在表面

球A的电量只可能在球的表面

壳B有两个表面

电量可能分布在内、外两个表面

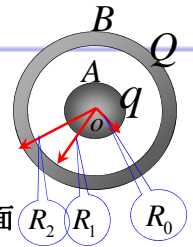
由于A B同心放置

仍维持球对称

∴ 电量在表面均匀分布

2017/4/11

26



球A均匀分布着电量 q

相当于一个均匀带电的球面

由高斯定理和电量守恒

可以证明壳B的电量分布是

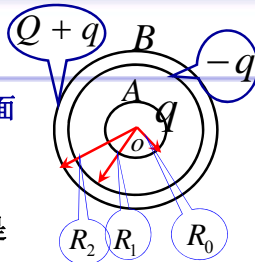
$$Q_{B内} = -q$$

$$Q_{B外} = Q + q$$

相当于均匀带电的球面

2017/4/11

27



证明壳B上电量的分布：

在B内紧贴内表面作高斯面 S

面S的电通量 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$

高斯定理

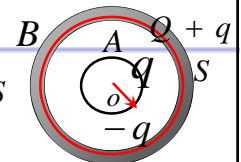
$$\sum_i q_i = 0 \rightarrow Q_{B内} = -q$$

电荷守恒定律

$$Q_{B外} = Q + q$$

2017/4/11

28



方法一：用场强线积分做此题：

根据高斯定理可求出场强的分布

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{r}^0 \quad (R_0 < r < R_1)$$

$$\vec{E} = 0 \quad (R_1 < r < R_2)$$

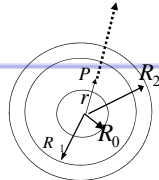
$$\vec{E} = \frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{r}^0 \quad (r > R_2)$$

P点的电势

$$U = \int_r^\infty E dr' = \int_r^{R_1} E dr' + \int_{R_1}^{R_2} E dr' + \int_{R_2}^\infty E dr'$$

2017/4/11

29



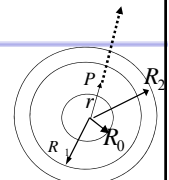
$$\begin{aligned} U &= \int_r^\infty E dr' = \int_r^{R_1} E dr' + \int_{R_1}^{R_2} E dr' + \int_{R_2}^\infty E dr' \\ &= \int_r^{R_1} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r'^2} dr' + \int_{R_1}^{R_2} \frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0 r'^2} dr' \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_1} \right) + \frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0 R_2} \end{aligned}$$

这也是 $r \leq R_0$ 的电势即 U_A 的电势

U_B 电势的积分限？

2017/4/11

30





方法二：等效：在真空中三个均匀带电的球面。利用叠加原理：

求其电势：

$$U_A = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_0} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

$$U_B = \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

